01;07;09 Двойной радиооптический резонанс в атомарных парах ⁸⁷Rb в ячейке с антирелаксационным стеночным покрытием

© А.Н. Литвинов,¹ Г.А. Казаков,² Б.Г. Матисов,² И.Е. Мазец¹

¹ Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,
 194021 Санкт-Петербург, Россия
 e-mail: anprolvy@list.ru
 ² Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
 195521 Санкт-Петербург, Россия
 e-mail: kazjor@rambler.ru

(Поступило в Редакцию 22 мая 2008 г.)

Исследовано формирование двойного радиооптического резонанса в атомарных парах ⁸⁷Rb в ячейке с антирелаксационным покрытием. В рамках квантово-кинетического подхода исследовано сужение Дикке. Установлено, что использование лазера с "широким" спектром излучения для оптической накачки позволяет улучшить кратковременную стабильность стандарта частоты на порядок по сравнению с использованием лазера с "узким" спектром излучения.

PACS: 32.80.Bv, 06.30.Ft, 42.50.Gy

Введение

Двойной радиооптический резонанс (ДРОР) представляет собой взаимодействие бихроматического излучения (состоящего из резонансных оптического и микроволнового полей) с атомами. Этот эффект является базой для создания магнитометров [1-4] и квантовых стандартов частоты [4,5]. Магнитометры имеют широкое применение в таких областях, как геологоразведка [6], подводная разведка, фундаментальная физика и т.п. Кроме того, в последнее время круг их приложений стремительно развивается и внедряется в такие несвойственные для них области, как, например, медицина. Недавно национальным институтом стандартов и технологий США был продемонстрирован [7] оптический магнитометр с чувствительностью 70 fHz^{-1/2} при комнатной температуре, что открывает ряд новых применений подобных приборов, например, — детектирование магнитных полей сердца и головного мозга [8]. Это дает значительно более богатую информацию о работе этих органов по сравнению с традиционными методами. Другая область применения магнитометров — измерение слабых магнитных полей в пространстве, что важно, например, для исследования объектов ближнего и дальнего космоса [9], предсказания сейсмической активности [6] и т.п.

Применение квантовых стандартов частоты имеет не меньшую степень важности, в частности, при создании систем навигации и позиционирования (GPS, GLONASS, GALILEO), устройств синхронизации оборудования телекоммуникационных сетей, при проверке фундаментальных физических законов.

Важной характеристикой любого квантового дискриминатора является параметр качества Q, который определяется амплитудой и шириной резонанса. Эти параметры существенным образом зависят от времени когерентного взаимодействия атома с возбуждающими полями. Основной причиной, которая препятствует атому быть длительное время в когерентном состоянии с оптическим и микроволновым полями, является его деполяризация при столкновении со стенкой ячейки.

Другой проблемой является доплеровское уширение радиочастотного перехода, которое можно интерпретировать как уход движущегося атома из области с определенной фазой поля (размеры этой области — порядка длины волны λ микроволнового поля) что, в свою очередь, также приводит к сокращению времени когерентного взаимодействия атома с полем. Таким образом, основные трудности, связанные с улучшением параметра качества, касаются увеличения этого времени.

Существует два основных способа увеличения времени когерентного взаимодействия атома с возбуждающими полями: введение буферного газа в ячейку с активными атомами, либо использование ячейки с антирелаксационным покрытием стенок. При введении в ячейку с активными атомами буферного газа (т.е. такого газа, при столкновении с атомами или молекулами которого активные атомы практически не деполяризуются), концентрация которого превышает примерно на 6 порядков концентрацию активных атомов, резко уменьшается длина свободного пробега активных атомов, и соответственно существенно снижается их деполяризация при столкновении со стенками, так и скорость их перемещения на расстоянии порядка λ. Данный метод имеет ряд недостатков, самый значительный из которых — это сдвиг и уширение частоты эталонного перехода, вызванные обменным отталкиванием Паули и притяжением ван-дер-Ваальса (которые не компенсируют друг друга) при столкновении парамагнитных активных атомов с диамагнитными атомами или молекулами буферного газа.

Этих недостатков лишен другой способ, более 50 лет назад предложенный Робинсоном и др. [10], который

состоит в покрытии стенок ячейки специальным антирелаксационным составом, в качестве которого обычно используют парафин. При этом вероятность деполяризации атома при столкновении со стенкой значительно (на 4 порядка [11]) снижается. Недавно было экспериментально установлено, что антирелаксационное покрытие весьма слабо "стареет" (сдвиг частоты микроволнового перехода составляет менее 10 Hz за 30 лет [1]), что опровергает имевшиеся ранее предположения о коротком сроке службы антирелаксационного покрытия. Например, в [12] исследовался ДРОР в ячейках такого типа, ширина резонанса составила 47 Hz.

Целью настоящей работы является исследование формирования ДРОР в атомарных парах ⁸⁷Rb в ячейке без буферного газа при лазерной накачке как с антирелаксационным покрытием стенок, так и без него. Теоретические исследования ДРОР базируются на основе квантовых кинетических уравнений для матрицы плотности. Тип покрытия стенок учитывается при помощи граничных условий.

В отличие от работы [13], где рассматривалось формирование ДРОР для трехуровневой модели, в настоящей работе исследуется ДРОР для реального атома ⁸⁷Rb с учетом сверхтонкой и зеемановской структуры как основных, так и возбужденных состояний.

1. Квантовые кинетические уравнения для ДРОР

Рассмотрим атом рубидия ⁸⁷Rb, который взаимодействует с лазерным и микроволновым полями. Атом помещен также во внешнее постоянное магнитное поле **B**, снимающее вырождение по проекции на задаваемую магнитным полем ось квантования полного момента атома. Участвующие в возбуждении уровни атома ⁸⁷Rb разобьем на две большие группы — уровни — основного $S_{1/2}$ -состояния (g), и уровни возбужденного $P_{1/2}$ - или $P_{3/2}$ -состояния (e). В свою очередь, уровни основного состояния будем подразделять на две подгруппы (g₁) и (g₂), соответствующие сверхтонким компонентам



g

основного состояния с полными моментами $F_g = 1$ и 2 соответственно (рис. 1).

Оптическое E и микроволновое H поля имеют следующий вид

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}_0 \exp[i(\mathbf{kr} - \omega t)] + c.c., \qquad (1)$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r},t) = \mathbf{H}_0 \exp[i(\mathbf{qr} - \omega_{rf}t)] + c.c., \qquad (2)$$

где \mathbf{E}_0 и \mathbf{H}_0 — амлитуда, \mathbf{k} и \mathbf{q} — волновой вектор, ω и ω_{rf} — частота лазерного и микроволнового полей соответственно.

Для описания взаимодействия атома с полями $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ и $\mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$ используется аппарат матрицы плотности $\hat{\rho}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ в представлении Вигнера. Уравнения для элементов ρ_{ij} матрицы плотности атомной системы во внешнем электромагнитном поле имеют вид

$$\dot{\rho}_{ij}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) \equiv \frac{\partial \rho_{ij}}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{m} \nabla \rho_{ij}$$
$$= -\frac{i}{\hbar} \sum_{k} [H_{ik} \rho_{kj} - \rho_{ik} H_{kj}] + (\hat{\hat{\Gamma}} \hat{\rho})_{ij}. \quad (3)$$

Здесь H_{ik}, H_{kj} — элементы гамильтониана \hat{H}, Γ — релаксационный оператор, m — масса атома.

Гамильтониан Н может быть представлен в виде

$$\ddot{H} = \ddot{H}_0 + \hbar \ddot{V},\tag{4}$$

где $\hat{H_0}$ — гамильтониан атома в отсутствие излучения, а $\hbar \hat{V}$ описывает взаимодействие атома с оптическим и микроволновым полями. Положим, что оптическое поле резонансно переходу $|F_g = 2\rangle \leftrightarrow |F_e\rangle$, а микроволновое — переходу $|F_g = 1\rangle \leftrightarrow |F_g = 2\rangle$, тогда вид оператора \hat{V} следующий:

$$\hat{V} = |e\rangle V_{eg_2} \exp\left[i(\mathbf{kr} - \omega t)\right] \langle g_2| + |g_2\rangle U_{g_1g_2}^0$$
$$\times \exp\left[i(\mathbf{qr} - \omega_{rf}t)\right] \langle g_1| + h.c.,$$
(5)

где $V_{eg_2}^0$ и $U_{g_1g_2}^0$ — частоты Раби для оптического и микроволнового полей соответственно.

Рассмотрим теперь матричные элементы $\Gamma_{ij,kl}$ релаксационного оператора $\hat{\Gamma}$, входящего в уравнение (3). Элементы $\Gamma_{ee,ee} = -\gamma \approx -3.5 \cdot 10^7 \text{s}^{-1}$ определяют скорость релаксации населенностей возбужденных уровней за счет спонтанного распада. Приход населенностей в основное состояние за счет распада возбужденных уровней описывается элементами $\Gamma_{gg,ee} = \gamma P_{ge}$, где P_{ge} вероятность перехода атома с уровня *e* на уровень *g* при спонтанном распаде [14]

$$P_{ge} = (2F_g + 1)(2J_e + 1) \left(C_{F_g m_g 1q}^{F_e m_e} \begin{cases} J_g & I & F_g \\ F_e & 1 & J_e \end{cases} \right)^2.$$
(6)

Здесь J_e и J_g — моменты электронной оболочки, F_e и F_g — полные моменты атома, m_e и m_g — проекции полного момента атома в состояниях $|e\rangle$ и $|g\rangle$

Ε. ω

H, ω_{rf}

 $F_{\sigma} = 1$

соответственно, I = 3/2 — момент ядра, $q = m_e - m_g$, $C_{F_g m_g 1q}^{F_e m_e}$ — коэффициент Клебша-Гордана, выражение в фигурных скобках представляет собой 6*J*-символ.

Распад "оптических когерентностей" ρ_{eg} в отсутствие буферного газа описывается элементами вида $\Gamma_{eg,eg} = -\gamma'; \gamma' = \gamma/2$ [15]. Релаксация "радиочастотных когерентностей" $\rho_{gg'}, g \neq g'$ описывается элементами $\Gamma_{gg',gg'} = -\Gamma_{\perp}$ и в основном обусловлена столкновениями между активными атомами. Она пропорциональна их концентрации, которая определяется температурой ячейки. Процессы деполяризации основного состояния учитываются посредством элементов вида $\Gamma_{gg,g'g'} = \Gamma_{\parallel} \tilde{P}_{gg'}, g \neq g'$ и $\Gamma_{gg,gg} = -\Gamma_{\parallel}$, где $\Gamma_{\parallel} \leq \Gamma_{\perp}$ скорость деполяризации, а $\tilde{P}_{gg'}$ — вероятность перехода атома с уровня g' на уровень g.

В представленном случае полагается, что переходы между этими уровнями равновероятны:

$$\tilde{P}_{gg'} = (2(F_{g_1} + F_{g_2}) + 1)^{-1}, \quad g \neq g'.$$

Перейдя во вращающуюся систему координат и произведя адиабатическое исключение населенностей ρ_{ee} возбужденных состояний и оптических когерентностей ρ_{eg} , получим систему уравнений для населенностей ρ_{gg} и когерентностей $\rho_{gg'}$

$$\begin{split} \dot{\rho}_{g_{1}g_{1}'} &= -i \left[(\omega_{g_{1}g_{1}'} - i\Gamma_{\perp})\rho_{g_{1}g_{1}'} \right] \\ &+ \sum_{g_{2}} (U_{g_{1}g_{2}}^{0}\rho_{g_{2}g_{1}'} - \rho_{g_{1}g_{2}}U_{g_{2}g_{1}'}^{0}) \right] \\ &+ \delta_{g_{1}g_{1}'} \left[\Gamma_{\perp}\rho_{g_{1}g_{1}'} - \Gamma_{\parallel} \left(\rho_{g_{1}g_{1}} - \sum_{g''} \tilde{P}_{g_{1}g''}\rho_{g''g''} \right) \right) \\ &+ \sum_{e,g_{2}'',g_{2}'''} 2P_{g_{1}e} \frac{V_{eg_{1}'}^{0}V_{g_{1}''e}^{0}}{\gamma'} \tilde{G}_{e}\rho_{g_{2}''g_{2}''} \right], \\ \dot{\rho}_{g_{2}g_{2}'} &= -i \left[\left(\omega_{g_{2}g_{2}'} - \Delta_{se}(1 - \delta_{g_{2}g_{2}'}) - i\Gamma_{\perp} \right) \rho_{g_{2}g_{2}'} \right. \\ &+ \sum_{g_{1}} \left(U_{g_{2}g_{1}}^{0}\rho_{g_{1}g_{2}'} - \rho_{g_{2}g_{1}}U_{g_{1}g_{2}'}^{0} \right) \\ &+ \sum_{g_{1}} \left(V_{g_{2}g_{1}}^{0}\rho_{g_{1}g_{2}'} - \rho_{g_{2}g_{1}}U_{g_{1}g_{2}'}^{0} \right) \\ &+ \sum_{e,g_{2}''} \frac{V_{g_{2}e}^{0}V_{eg_{2}''}^{0}}{\gamma'} \left[\tilde{F}_{e} - i\tilde{G}_{e} \right] \rho_{g_{2}g_{2}''} \\ &+ \delta_{g_{2}g_{2}'} \left[\Gamma_{\perp}\rho_{g_{2}g_{2}'} - \Gamma_{\parallel} \left(\rho_{g_{2}g_{2}} - \sum_{g''} \tilde{P}_{g_{2}g''}\rho_{g''g''} \right) \right) \\ &+ \sum_{e,g_{2}''} 2P_{g_{2}e} \frac{V_{eg_{2}''}^{0}V_{g_{2}''e}^{0}}{\gamma'} \tilde{G}_{e} \end{bmatrix},$$

$$(7)$$

$$\begin{split} \dot{\rho}_{g_{1}g_{2}} &= -i \left[(\omega_{rf} - \Delta_{se} - \omega_{g_{2}g_{1}} - \mathbf{q}\boldsymbol{v} - i\Gamma_{\perp}) \rho_{g_{1}g_{2}} \right. \\ &+ \sum_{g_{2}'} U_{g_{1}g_{2}'}^{0} \rho_{g_{2}'g_{2}} - \sum_{g_{1}'} \rho_{g_{1}g_{1}'} U_{g_{1}'g_{2}}^{0} \\ &- \sum_{e,g_{2}'} \frac{V_{g_{2}e}^{0} V_{eg_{2}}^{0}}{\gamma'} \left[\tilde{F}_{e} + i\tilde{G}_{e} \right] \rho_{g_{1}g_{2}'} \right]. \end{split}$$

Здесь ω_{ij} — частота перехода между *i*-м и *j*-м уровнями, $v = \mathbf{p}/m$ — скорость атома, δ_{ij} — символ Кронекера, Δ_{se} — сдвиг, вызванный спин-обменным взаимодействием атомов, а вещественные коэффициенты \tilde{F}_e и \tilde{G}_e определяются выражением

$$\tilde{G}_e + i\tilde{F}_e = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\gamma' J(\omega')}{\gamma' - i(\omega' - \omega_{eg_2} + \Omega_L - \mathbf{k}\boldsymbol{v})} \, d\omega', \quad (8)$$

где $J(\omega')$ — спектральная плотность лазерного излучения, нормированная на единицу:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} J(\omega')d\omega' = 1.$$

В настоящей работе рассматривается стационарный режим, поэтому в левой части уравнений (7) частная производная по времени полагается равной нулю.

Зеемановское расщепление соседних магнитных подуровней одного сверхтонкого уровня (например, $|g_2\rangle$) основного состояния составляет примерно 0.7 MHz/G, что в слабых магнитных полях, используемых в квантовых дискриминаторах стандартов частоты для снятия вырождения (менее 1 G), много меньше как доплеровской ширины $\Delta_D = 2\sqrt{\ln 2} k v_T (v_T$ — ниболее вероятная скорость атомов) оптического перехода, так и скорости γ' распада оптической когерентности, поэтому в выражении (8) можно пренебречь зависимостью величины ω_{eg_2} от g_2 .

Если спектральная плотность лазерного излучения представляет собой лоренциан шириной Γ_L , что соответствует диффузионной модели фазовых шумов [16]

$$J(\omega') = \frac{\Gamma_L/2\pi}{(\omega - \omega')^2 + \Gamma_L^2/4},$$
(9)

то выражение (8) существенно упрощается:

$$\tilde{G}_e + i\tilde{F}_e = \frac{\gamma' + \Gamma_L/2}{\gamma' + \Gamma_L/2 - i(\omega + \Omega_L - \mathbf{k}\upsilon)}.$$
 (10)

В случае доминирования других типов шумов необходимо использовать формулу (8).

Населенности возбужденного состояния определяются выражением

$$\rho_{\text{exc}} = \sum_{e,g_2'',g_2'''} 2 \frac{V_{eg_2''}^0 V_{g_2'''e}^0}{\gamma \gamma'} \tilde{G}_e \rho_{g_2''g_2'''}.$$
 (11)

Журнал технической физики, 2009, том 79, вып. 2

Поскольку при температуре 50°С доплеровская ширина $\delta_D = 2\sqrt{\ln 2} q v_T$ перехода $|F_g = 1, m\rangle \leftrightarrow |F_g = 2, m\rangle$ составляет около 8 kHz, а например, при величине постоянного магнитного поля B = 0.05 G разница частот эталонного перехода $|F_g = 1, m = 0\rangle \leftrightarrow |F_g = 2, m = 0\rangle$ и $|F_g = 1, m = \pm 1\rangle \leftrightarrow |F_g = 2, m = \pm 1\rangle$ составляет около 70 kHz, то можно пренебречь переходами с уровней $|F_g = 1, m = \pm 1\rangle$ на уровни $|F_g = 2, m = \pm 1\rangle$, индуцированные микроволновым полем. При этом удобно ввести отстройку Ω_{rf} микроволнового поля

$$\Omega_{rf} = \omega_{rf} - \omega_{21}, \qquad (12)$$

где $|1
angle=|F_g=1,m=0
angle, \quad |2
angle=|F_g=2,m=0
angle.$

Поскольку характерное значение импульса атома много больше импульса фотона, а концентрация активных атомов мала (длина свободного пробега активных атомов составляет сотни метров), оператор эволюции матрицы плотности можно считать локальным по координате и по импульсу. В нашей модели поступательные степени свободы атомов подчиняются равновесному распределению, что приводит к условию нормировки вида

$$\sum_{i} \rho_{ii}(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \frac{M(\mathbf{p})}{V_{\text{cell}}},$$

где

$$M(\mathbf{p}) = \frac{\exp(-p^2/p_T^2)}{(p_T \sqrt{\pi})^3}$$
(13)

— функция распределения Максвелла, $p_T = \sqrt{2k_BmT}$, k_B — постоянная Больцмана, V_{cell} — объем ячейки.

В модели, используемой в настоящей работе, делаются следующие предположения относительно соударения атома со стенкой. Во-первых, отражение атома от стенок ячейки считается зеркальным, т. е. импульсы **p** и **p**' атома до и после соударения со стенкой связаны соотношением $\mathbf{p}' = \mathbf{p} - 2\mathbf{n}(\mathbf{n}\mathbf{p})$, где **n** — единичный вектор нормали к поверхности *S* ячейки. Во-вторых, процессы атомной деполяризации не зависят от скорости, с которой атом сталкивается со стенкой. В-третьих, при столкновениях, сопровождающихся деполяризацией, переходы между различными подуровнями основного состояния равновероятны. Тогда для элементов матрицы плотности можно записать следующие граничные условия:

$$\bar{\rho}_{gg}(\mathbf{p}') - \rho_{gg}(\mathbf{r}, \mathbf{p}')_{r \in S} = \beta \left(\bar{\rho}_{gg}(\mathbf{p}) - \rho_{gg}(\mathbf{r}, \mathbf{p})_{r \in S} \right),$$
$$\rho_{gg'}(\mathbf{r}, \mathbf{p}')_{r \in S} = \alpha \rho_{gg'}(\mathbf{r}, \mathbf{p})_{r \in S}, \quad g \neq g'.$$
(14)

Здесь $\bar{\rho}_{gg}(\mathbf{p}) = M(\mathbf{p})/(8V_{cell})$ — диагональный элемент матрицы плотности, соответствующий полной деполяризации атомов. Коэффициенты α и β ($0 \le \alpha, \beta \le 1$) характеризует степень релаксации населенностей ρ_{gg} и когерентностей $\rho_{gg'}$ в результате соударения атомов со стенкой.

В том случае, если стенка ячейки покрыта специальным антирелаксационным составом, таким как, например, длинноцепочные парафины, то атомы весьма слабо адсорбируются на стенках и дисперсия фазы также мала. Поэтому для полной деполяризации атома требуется очень большое число соударений. Идеализацией такой ситуации являются граничные условия зеркально-когерентного типа [13]

$$\alpha = \beta = 1. \tag{15}$$

Другой крайний случай имеет место, когда каждое столкновение активного атома со стенкой приводит к полной дезориентации спина. Такая ситуация для стеклянных кювет с парами щелочных элементов и обусловлена весьма существенной дисперсией магнитного поля. В пирексе разброс локальных магнитных полей достигает 5 G в связи со значительным содержанием в нем магнетита (0.1%), образующего ферромагнитные домены. Этому взаимодействию соответствуют граничные условия *полного гашения*: полная релаксация когерентностей и выравнивание населенностей в потоке атомов, летящих от стенки [13]

$$\alpha = \beta = 0. \tag{16}$$

Решив систему (7) с граничными условиями (14), используя выражение (8) и произведя интегрирование по объему ячейки и по импульсам, найдем населенность в возбужденном состоянии

$$\bar{\rho}_{\rm exc} = \iint \rho_{\rm exc}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d\mathbf{r} d\mathbf{p}.$$
 (17)

Поглощаемая в ячейке мощность δP лазерного излучения пропорциональна $\bar{\rho}_{\rm exc}$ [17]:

$$\delta P = \hbar \omega \gamma N \bar{\rho}_{\text{exc}},\tag{18}$$

где N — число активных атомов в ячейке.

2. Результаты численного расчета

В данной работе рассматривается оптическая накачка π -поляризованным лазерным полем на D_1 -линии. Под π -поляризацией понимается ситуация, при которой лазерное излучение поляризовано линейно, направление его распространения ортогонально, а направление поляризации совпадает с направлением постоянного магнитного поля **В**. Величина магнитного поля составляет B = 0.05 G.

Схема возбуждения ДРОР представлена на рис. 2, а геометрия, в которой реализуется подобная схема — на рис. 3.

Сигнал ДРОР — это зависимость сигнала тока j фотодетектора от отстройки Ω_{rf} микроволнового поля. Поскольку поглощенная мощность пропорциональна $\bar{\rho}_{exc}$, мы будем под сигналом ДРОР понимать зависимость $\bar{\rho}_{exc}(\Omega_{rf})$.

Определим для начала основные параметры резонанса, такие как амплитуда, ширина и контраст резонанса [18]. *Амплитудой* ДРОР назовем разность $\bar{\rho}_{exc}^{NR} - \bar{\rho}_{exc}^{R}$,



Рис. 2. Схема возбуждения ДРОР в атоме ⁸⁷Rb. Микроволновое поле действует на эталонном переходе $|F_g = 1$, $m = 0 \rangle \leftrightarrow |F_g = 2, m = 0 \rangle$ (двойная стрелка), а π -поляризованное лазерное поле накачки — на переходах $|F_g = 2 \rangle \leftrightarrow |F_e \rangle$ (одинарные линии).



Рис. 3. Конфигурация, реализующая накачку *л*-поляризованным лазерным полем.

где $\bar{\rho}_{\rm exc}^{NR}$ — населенность вне резонанса, а $\bar{\rho}_{\rm exc}^{R}$ — в резонансе; *ширину* ДРОР на половине высоты обозначаем $\Gamma_{\rm DROR}$, а *контрастом* назовем отношение

$$C(\Omega_{rf}) = \frac{\bar{\rho}_{\text{exc}}(\Omega_{rf}) - \bar{\rho}_{\text{exc}}^{NR}}{\bar{\rho}_{\text{exc}}(\Omega_{rf})}$$

которое удобно для графического представления сигнала ДРОР.

В работе рассмотрен случай, когда оптическое поле настроено в резонанс с переходом $|F_g = 2\rangle \leftrightarrow |F_e = 1\rangle$, при этом, поскольку расстояние между сверхтонкими подуровнями возбужденного состояния составляет 817 MHz, а доплеровская ширина оптического перехода $\Delta_D \approx 500$ MHz, принимаются во внимание также переходы $|F_g = 2\rangle \leftrightarrow |F_e = 2\rangle$, индуцированные оптическим полем. Микроволновое излучение действует на эталонном переходе $|F_g = 1, m = 0\rangle \leftrightarrow |F_g = 2, m = 0\rangle$.

В работе исследуется форма сигнала ДРОР для двух типов лазеров, отличающихся шириной Γ_L спектра излучения $\Gamma_L \approx \Delta_D$ и $\Gamma_L \leq \gamma$. Для краткости будем называть лазер с шириной спектра $\Gamma_L \approx \Delta_D$ "широким" лазером, а лазер с $\Gamma_L \leq \gamma$ — "узким".

Перейдем к результатам численного расчета и анализа ДРОР для двух типов граничных условий.

Зеркально-когерентные граничные условия

На рис. 4 представлены результаты расчета ДРОР для зеркально-когерентных граничных условий. Вначале рассмотрим случай "широкого" лазера (рис. 4, *a*). Из рисунка видно (кривая для $\lambda/4$ и $3\lambda/4$) влияние сужения Дикке [19] на форму ДРОР при длине ячейки $a < \lambda$. При длине ячейки $a \ge \lambda$ наблюдается влияние эффекта радиоиндуцированного переноса (РИП) чистых и смешанных квантовых состояний на форму ДРОР (кривая 1). Этот эффект был впервые рассмотрен в [13,20,21] для трехуровневой модели.

Физической сутью возникновения РИП является обусловленная эффектом Доплера селективность (по скоростям) взаимодействия радиочастотного поля с активными атомами. Она приводит к появлению беннетовских провалов и пиков [22] в распределении по скоростям атомов в долгоживущих состояниях |1 и |2, образующих переход, взаимодействующий с микроволновым полем.



Рис. 4. Форма линии ДРОР для разных значений длин a $(I - a = \lambda, 2 - 3\lambda/4, 3 - \lambda/4)$ ячейки для зеркальнокогерентных граничных условий, $\Gamma_{\perp} = 100 \text{ s}^{-1}$. a — "широкий" лазер, b — "узкий" лазер; $U^0 = 300 \text{ s}^{-1}$, $I = 20 \,\mu$ W/cm². На вставке изображена форма линии ДРОР в более узком диапазоне Ω_{rf} .

Журнал технической физики, 2009, том 79, вып. 2

Теперь перейдем к случаю, когда для оптической накачки используется "узкий" лазер. Результаты представлены на рис. 4, b. Из рисунка (кривая для $\lambda/4$ и $3\lambda/4$) видно, что, во-первых, наблюдается влияние эффекта Дикке на форму ДРОР, имеющего место, так же как и в случае "широкого" лазера, при $a \leq \lambda$. По сравнению с "широким" лазером контраст ДРОР в этом случае примерно в 2 раза меньше, поскольку при накачке "узким" лазером в формировании резонанса участвуют только атомы определенной скоростной группы.

Вторая особенность, связанная с использованием "узкого" лазера, — влияние эффекта зерно-индуцированного переноса (ЛИП) квантовых состояний [23,24] на форму ДРОР, имеющего место при длине ячейки $a \ge \lambda/8$.

Эффект ЛИП возникает аналогично РИП, а именно появляются потоки атомов в разных долгоживущих состояниях. Однако в этом случае появление беннетовских провалов и пиков, и соответственно возникновение асимметрии распределений по скоростям, вызвано использованием "узкого" лазера. Отметим, что ЛИП наблюдается как в стоячей, так и в бегущей волне микроволнового излучения, в то время как, для того чтобы наблюдать РИП, необходимо, чтобы микроволновое излучение представляло собой бегущую волну.

Заметим, что как РИП, так и ЛИП, играют весьма важную, а в некоторых случаях определяющую роль в формировании ДРОР, но при размерах ячейки $a < \lambda/8$ эти эффекты исчезают. В данной работе рассматривается одномерная модель "плоского слоя". В реальных ячейках (трехмерных) наличие боковых стенок ячейки (как и использование частотной модуляции микроволнового поля) приводит к гашению РИП и ЛИП, поэтому наблюдение этих эффектов весьма затруднено.

В [1,12,25] из-за трехмерного движения атомов и использования слабых микроволновых и оптических полей не наблюдалось влияние эффекта ЛИП на форму ДРОР. В [26] исследовался ДРОР в сильных полях, и авторы работы обнаружили проявление ЛИП. Интересно отметить, что этот эффект наблюдался в стеклянной (без антирелаксационного стеночного покрытия) ячейке. Далее будет рассмотрена такая ситуация.

Вместе с этим результаты, которые касаются наблюдения эффекта Дикке, остаются справедливыми и при учете трехмерного движения атома. Соответствующий анализ был проведен в [27]. Приведем его результаты.

В одномерной модели длина свободного пробега атома равна длине *а* ячейки, а частота соударений со стенками $v = |v_z|/a$. Это означает частотную модуляцию микроволнового излучения с частотой v, приводящую к возникновению в дополнение к центральной частоте v_{21} двух боковых — $v_{21} \pm v$. Усреднение по ансамблю атомов даст кроме узкого центрального пика еще и широкий пьедестал. В трехмерной кювете радиуса *а* длина свободного пробега уже не фиксирована и пробегает значения от нуля до *а*. Частота модуляции изменяется от v до ∞ , так что вместо двух боковых частот имеются боковые полосы. Это изменяет форму пьедестала, но по-прежнему будет иметь место узкий центральный пик (сужение Дикке). Отметим, что "трехмерность" ячейки по отношению к "одномерности" приводит к усилению эффекта Дикке, а трехмерное движение атома ведет к сглаживанию и гашению ЛИП и РИП.

Граничные условия полного гашения (стеклянная кювета)

В этом случае сигнал ДРОР при небольших интенсивностях лазерного поля и частотах Раби микроволнового излучения, которые рассматривались в предыдущем пункте, достаточно слаб для экспериментального обнаружения. Поэтому для наблюдения сигнала ДРОР в стеклянной ячейке необходимо повысить частоту Раби микроволнового поля и интенсивность оптической накачки на несколько порядков. В [26] обнаружен провал в центре линии ДРОР в сильных полях в атомарных парах ⁸⁵Rb, что является прямым следствием влияния ЛИП на форму ДРОР.

В результате сопоставления результатов с экспериментом [26] (рис. 5) было получено хорошее количественное согласие. Интересен тот факт, что существует критическая интенсивность оптического поля, при которой происходит кардинальное изменение формы сигнала



Рис. 5. Сигнал ДРОР при разных значениях интенсивности оптического поля при граничных условиях полного гашения, в качестве оптической накачки использовался "узкий" лазер. Точками обозначен эксперимент [26] (черные и прозрачные точки соответствуют разным интенсивностям накачки). Сплошные линии — наш расчет. Параметры взяты из [26] (частота Раби микроволнового поля, интенсивность оптического поля, размер ячейки и др.).

ДРОР, и она зависит от частоты Раби микроволнового поля [26].

5. Кратковременная стабильность в пределе дробового шума

Проанализируем кратковременную стабильность $\sigma(\tau)$ квантового дискриминатора стандарта частоты на ячейке с антирелаксационным стеночным покрытием, которая обратно пропорциональна параметру качества Q. В пределе дробового шума $\sigma(\tau)$ определяется выражением [5,17]

$$\sigma(\tau) = \frac{\sqrt{je}}{S\tilde{\Gamma}\omega_{hfs}\sqrt{\tau}},\tag{19}$$

где $\tilde{\Gamma}$ — ширина линейного участка дискриминационной кривой (участок вблизи максимума резонанса, на котором вторая производная фототока по отстройке микроволнового поля остается практически постоянной), S — крутизна, равная модулю второй производной по отстройке Ω_{rf} в максимуме поглощения излучения, e — заряд электрона, ω_{hfs} — частота сверхтонкого перехода основного состояния, τ — время усреднения.

На рис. 6 представлены графики кратковременной стабильности для ДРОР в зависимости от интенсивности лазерного поля. Из рисунка видно, что наилучшее значение кратковременной стабильности может быть получено в случае использования "широкого" лазера (для "узкого" лазера стабильность на порядок хуже). Оптимальная интенсивность оптического излучения равна $I \sim 6-10 \mu$ W/cm². Причина различия кратковременной стабильности для двух типов лазеров накачки состоит в том, что при использовании "широкого" лазера количество атомов, которые участвуют в формировании ДРОР, существенно превосходит количество атомов,



Рис. 6. Зависимость кратковременной стабильности (для времени интегрирования $\tau = 1 \text{ s}$) от интенсивности лазерного поля при зеркально-когерентных граничных условиях. Длина ячейки a = 3 cm, $\Gamma_{\perp} = 100 \text{ s}^{-1}$, $U^0 = 300 \text{ s}^{-1}$. Сплошная кривая соответствует "широкому" лазеру; штрихпунктрир — "узкому".

участвующих в формировании ДРОР в случае "узкого" лазера.

При накачке "узким" лазером значение стабильности составляет $\sim 10^{-13}$. Наши оценки стабильности подтверждают экспериментальную работу [28], в которой величина кратковременной стабильности составила $\sim 2\cdot 10^{-13}$. Здесь важно отметить, что расчет проведен в пределе дробового шума, т.е. без учета амплитудных шумов и дрейфа частоты лазера, шумов электронной техники и т.п.

Выводы

В настоящей работе исследовано формирование радиооптического резонанса в атомарных парах ⁸⁷Rb в ячейке с антирелаксационным покрытием. Рассмотрены два типа лазеров для накачки, отличающихся шириной спектра излучения: "широкий" ($\Gamma_L \approx \Delta_D$) и "узкий" ($\Gamma_L \leq \gamma$). Показано, что имеет место сужение линии двойного радиооптического резонанса (эффект Дикке) при зеркально-когерентных граничных условиях. Использование лазера с "узким" спектром позволяет наблюдать влияние лазерно-индуцированного переноса долгоживущих состояний на форму сигнала двойного радиооптического резонанса. Установлено, что использование "широкого" лазера позволяет улучшить кратковременную стабильность на порядок по сравнению с использованием "узкого" лазера.

Несмотря на то что наша работа направлена главным образом на разработку высокоточных квантовых стандартов частоты, полученные результаты в полной мере актуальны и при разработке высокопрецизионных магнитометров.

Работа поддержана грантом INTAS-CNES-NSAU 06-1000024-9321 и фондом некоммерческих программ "Династия".

Список литературы

- Budker D., Hollberg L., Kimball D.F. et al. // Phys. Rev. A. 2005. Vol. 71. P. 012903.
- [2] Balabas M.V., Budker D., Kithing J. et al. // JOSA. B. 2006. Vol. 23. P. 1001.
- [3] Hodby E., Donley E.A., and Kitching J. // Appl. Phys. Lett. 2007. Vol. 91. P. 011 109.
- [4] Knappe S., Schwindt P.D.D., Gerginov V. et al. // J. Optics A: Pure Appl. Opt. 2006. Vol. 8. P. 318.
- [5] Vanier J., Audoin C. The quantum Physics of Atomic Frequency Standarts. Bristol: Adam Higler, 1989. 1567 p.
- [6] Померанцев Н.М., Рыжков В.М., Скроцкий Г.В. Физические основы квантовой магнитометрии. М., 1972. 448 с.
- [7] Shahl V., Knappe S., Schwindt P.D.D. et al. // Nature Photonics. 2007. Vol. 1. P. 649.
- [8] Budker D. and Romalis M. // Nature Physics. 2007. Vol. 3. P. 227.

- [9] Acuna M.H. Encyclopedia of Planetary Sciences / Ed. by J.H. Shirley & R.W. Fairbridge London, Chapman & Hall, 1997. P. 406–410.
- [10] Robinson H., Ensberg E., and Dehmelt H.T. // Bull. Am. Phys. Soc. 1958. Vol. 3. P. 9.
- [11] Graf M.T., Kimball D.F., Rochester S.M. et al. // Phys. Rev. A. 2005. Vol. 72. P. 023 401.
- [12] Guzman J.S., Wojciechowski A., Stalnaker J.E. et al. // Phys. Rev. A. 2006. Vol. 74. P. 053 415.
- [13] Агапьев Б.Д., Горный М.Б., Матисов Б.Г. // ЖТФ. 1988.
 Т. 58. С. 2286.
- [14] Варшалович Д.А., Москалев А.Н., Херсонский В.К. Квантовая теория углового момента. Л., 1975. 440 с.
- [15] Казаков Г.А., Матисов Б.Г., Мазец И.Е. и др. // ЖТФ. 2006. Т. 76. С. 20.
- [16] Мазец И.Е., Матисов Б.Г. // ЖЭТФ. 1992. Т. 101. С. 26.
- [17] Горный М.Б., Матисов Б.Г., Смирнова Г.М. и др. // ЖТФ. 1987. Т. 57. С. 740.
- [18] Kazakov G., Matisov B., Mazets I. et al. // Phys. Rev. A. 2005. Vol. 72. P. 063 408.
- [19] Dicke R.H. // Phys. Rev. 1953. Vol. 89. P. 472.
- [20] Агапьев Б.Д., Матисов Б.Г. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. С. 123.
- [21] Агапьев Б.Д., Матисов Б.Г. // Письма в ЖЭТФ. 1986. Т. 44. С. 66.
- [22] Benett W.R. // Phys. Rev. 1962. Vol. 126. P. 580.
- [23] Агапьев Б.Д., Горный М.Б., Матисов Б.Г. // Опт. и спектр. 1986. Т. 61. С. 1155.
- [24] Агапьев Б.Д., Горный М.Б., Матисов Б.Г. // ЖЭТФ. 1987.
 Т. 92. С. 1995.
- [25] Klein M., Novikova I., Phillips D.F. et al. // J. Mod. Opt. 2006. Vol. 53. P. 2583.
- [26] Зибров А.С., Жуков А.С., Яковлев В.П. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2006. Т. 83. С. 168.
- [27] Frueholz R.P. and Volk C.H. // J. Phys. B: At. Mol. Phys. 1985. Vol. 18. P. 4055.
- [28] Szekely C., Drullinger R.E., Walls F.L. et al. // Proc. IEEE Int. Frequency Control Symp. 1993. P. 41 518-41 521.